



4チャンネル、128/256ポジション、I²C 不揮発性デジタル・ポテンシオメータ

データシート

AD5123/AD5143

特長

- 10 kΩ および 100 kΩ の抵抗オプション
- 抵抗許容誤差: 最大 8%
- ワイパー電流: ±6 mA
- 小さい温度係数: 35 ppm/°C
- 広い帯域幅: 3 MHz
- 高速なスタートアップ・タイム: 75 μs 以下
- リニア・ゲイン設定モード
- 単電源動作と両電源動作が可能
- 広い動作温度: -40°C ~ +125°C
- 3 mm × 3 mm のパッケージ
- ESD 保護: 4 kV

アプリケーション

- ポータブル機器のレベル調整
- LCD パネルの輝度とコントラストの制御
- プログラマブルなフィルタ、遅延、時定数
- プログラマブルな電源

機能ブロック図

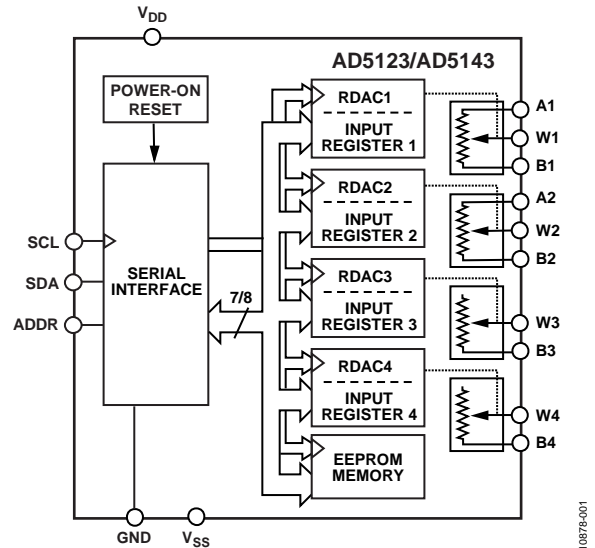


図 1.

概要

AD5123/AD5143 ポテンシオメータは、128/256 ポジションの調整を必要とするアプリケーションに対して不揮発性ソリューションを提供します。±8%の低抵抗許容誤差および Ax ピン、Bx ピン、Wx ピンで最大±6 mA の電流密度を保証しています。抵抗許容誤差と公称温度係数が小さいため、オープン・ループ・アプリケーションおよび許容誤差の一致が必要なアプリケーションが簡素化されます。

リニア・ゲイン設定モードを使うと、ストリング抵抗(R_{AW} および R_{WB})を使ってデジタル・ポテンシオメータ・ピン間の抵抗を独立に設定できるため、非常に正確に抵抗を一致させることができます。

これらのデバイスは、広い帯域幅と低い総合高調波歪み (THD) を持つため、AC 信号に対して最適性能を提供するので、フィルタ・デザインに適しています。

抵抗アレイ両端のワイパー抵抗が 40 Ω と小さいため、ピン-ピン間の接続が可能です。

ワイパー値は I²C 互換デジタル・インターフェースを経由して制御することができ、このインターフェースはワイパー・レジスタ値と EEPROM 値のリードバックにも使用することができます。

AD5123/AD5143 は、3 mm × 3 mm の小型 16ピン LFCSP パッケージを採用しています。これらのデバイスの動作は、工業用拡張温度範囲 -40°C ~ +125°C で保証しています。

表 1. ファミリー・モデル

Model	Channel	Position	Interface	Package
AD5123 ¹	Quad	128	I ² C	LFCSP
AD5124	Quad	128	SPI/I ² C	LFCSP
AD5124	Quad	128	SPI	TSSOP
AD5143	Quad	256	I ² C	LFCSP
AD5144	Quad	256	SPI/I ² C	LFCSP
AD5144	Quad	256	SPI	TSSOP
AD5144A	Quad	256	I ² C	TSSOP
AD5122	Dual	128	SPI	LFCSP/TSSOP
AD5122A	Dual	128	I ² C	LFCSP/TSSOP
AD5142	Dual	256	SPI	LFCSP/TSSOP
AD5142A	Dual	256	I ² C	LFCSP/TSSOP
AD5121	Single	128	SPI/I ² C	LFCSP
AD5141	Single	256	SPI/I ² C	LFCSP

¹ 2 個のポテンシオメータと 2 個の可変抵抗器。

Rev. A

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。
※日本語版資料は REVISION が古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。
©2012–2013 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

アナログ・デバイセズ株式会社

本 社 / 〒105-6891 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワービル
電話 03 (5402) 8200
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー
電話 06 (6350) 6868

目次

特長	1	テスト回路	18
アプリケーション	1	動作原理	19
機能ブロック図	1	RDAC レジスタと EEPROM	19
概要	1	入力シフトレジスタ	19
改訂履歴	2	I ² C シリアル・データ・インターフェース	19
仕様	3	I ² C アドレス	19
電気的特性—AD5123	3	高度な制御モード	21
電気的特性—AD5143	6	EEPROM または RDAC レジスタの保護	22
インターフェース・タイミング仕様	9	RDAC アーキテクチャ	25
シフトレジスタとタイミング図	10	可変抵抗のプログラミング	25
絶対最大定格	11	ポテンショメータ分圧器のプログラミング	26
熱抵抗	11	ピン電圧の動作範囲	26
ESD の注意	11	パワーアップ・シーケンス	26
ピン配置およびピン機能説明	12	レイアウトと電源のバイパス	26
代表的な性能特性	13	外形寸法	27
		オーダー・ガイド	27

改訂履歴

3/13—Rev. 0 to Rev. A	
Changes to Features Section	1
10/12—Revision 0: Initial Version	

仕様

電気的特性—AD5123

特に指定がない限り、 $V_{DD} = 2.3\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0\text{ V}$ ； $V_{DD} = 2.25\text{ V} \sim 2.75\text{ V}$ 、 $V_{SS} = -2.25\text{ V} \sim -2.75\text{ V}$ ； $-40^\circ\text{C} < T_A < +125^\circ\text{C}$ 。

表 2.

Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	Min	Typ ¹	Max	Unit
DC CHARACTERISTICS—RHEOSTAT MODE (ALL RDACs)						
Resolution	N		7			Bits
Resistor Integral Nonlinearity ²	R-INL	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$ $V_{DD} \geq 2.7\text{ V}$	-1	± 0.1	+1	LSB
		$V_{DD} < 2.7\text{ V}$ $R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$	-2.5	± 1	+2.5	LSB
Resistor Differential Nonlinearity ²	R-DNL	$V_{DD} \geq 2.7\text{ V}$	-0.5	± 0.1	+0.5	LSB
		$V_{DD} < 2.7\text{ V}$	-1	± 0.25	+1	LSB
Nominal Resistor Tolerance	$\Delta R_{AB}/R_{AB}$		-8	± 1	+8	%
Resistance Temperature Coefficient ³	$(\Delta R_{AB}/R_{AB})/\Delta T \times 10^6$	Code = full scale		35		ppm/ $^\circ\text{C}$
Wiper Resistance ³	R_W	Code = zero scale $R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$		55	125	Ω
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		130	400	Ω
Bottom Scale or Top Scale	R_{BS} or R_{TS}	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$		40	80	Ω
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		60	230	Ω
Nominal Resistance Match	R_{AB1}/R_{AB2}	Code = 0xFF	-1	± 0.2	+1	%
DC CHARACTERISTICS—POTENTIOMETER DIVIDER MODE (ALL RDACs)						
Integral Nonlinearity ⁴	INL	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$	-0.5	± 0.1	+0.5	LSB
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$	-0.25	± 0.1	+0.25	LSB
Differential Nonlinearity ⁴	DNL		-0.25	± 0.1	+0.25	LSB
			-0.25	± 0.1	+0.25	LSB
Full-Scale Error	V_{WFSE}	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$	-1.5	-0.1		LSB
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$	-0.5	± 0.1	+0.5	LSB
Zero-Scale Error	V_{WZSE}	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$		1	1.5	LSB
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		0.25	0.5	LSB
Voltage Divider Temperature Coefficient ³	$(\Delta V_W/V_W)/\Delta T \times 10^6$	Code = half scale		± 5		ppm/ $^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	Min	Typ ¹	Max	Unit
RESISTOR TERMINALS						
Maximum Continuous Current	I_A , I_B , and I_W	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$ $R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$	-6 -1.5		+6 +1.5	mA mA
Terminal Voltage Range ⁵			V_{SS}		V_{DD}	V
Capacitance A, Capacitance B ³	C_A , C_B	$f = 1\text{ MHz}$, measured to GND, code = half scale $R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$ $R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		25 12		pF pF
Capacitance W ³	C_W	$f = 1\text{ MHz}$, measured to GND, code = half scale $R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$ $R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		12 5		pF pF
Common-Mode Leakage Current ³		$V_A = V_W = V_B$	-500	± 15	+500	nA
DIGITAL INPUTS						
Input Logic ³						
High	V_{INH}		$0.7 \times V_{DD}$			V
Low	V_{INL}				$0.2 \times V_{DD}$	V
Input Hysteresis ³	V_{HYST}		$0.1 \times V_{DD}$			V
Input Current ³	I_{IN}				± 1	μA
Input Capacitance ³	C_{IN}			5		pF
DIGITAL OUTPUTS						
Output High Voltage ³	V_{OH}	$R_{PULL-UP} = 2.2\text{ k}\Omega$ to V_{DD}		V_{DD}		V
Output Low Voltage ³	V_{OL}	$I_{SINK} = 3\text{ mA}$ $I_{SINK} = 6\text{ mA}$			0.4 0.6	V V
Three-State Leakage Current			-1		+1	μA
Three-State Output Capacitance				2		pF
POWER SUPPLIES						
Single-Supply Power Range		$V_{SS} = \text{GND}$	2.3		5.5	V
Dual-Supply Power Range			± 2.25		± 2.75	V
Positive Supply Current	I_{DD}	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$ $V_{DD} = 5.5\text{ V}$ $V_{DD} = 2.3\text{ V}$		0.7 400	5.5	μA nA
Negative Supply Current	I_{SS}	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$	-5.5	-0.7		μA
EEPROM Store Current ^{3,6}	$I_{DD_EEPROM_STORE}$	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$		2		mA
EEPROM Read Current ^{3,7}	$I_{DD_EEPROM_READ}$	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$		320		μA
Power Dissipation ⁸	P_{DISS}	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$		3.5		μW
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	$\Delta V_{DD}/\Delta V_{SS} = V_{DD} \pm 10\%$, code = full scale		-66	-60	dB

Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	Min	Typ ¹	Max	Unit
DYNAMIC CHARACTERISTICS ⁹						
Bandwidth	BW	-3 dB				
		$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		3		MHz
Total Harmonic Distortion	THD	$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		0.43		MHz
		$V_{DD}/V_{SS} = \pm 2.5 \text{ V}$, $V_A = 1 \text{ V rms}$, $V_B = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$				
Resistor Noise Density	e_{N_WB}	$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		-80		dB
		$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		-90		dB
V_W Settling Time	t_S	Code = half scale, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $f = 10 \text{ kHz}$				
		$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		7		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
V_W Settling Time	t_S	$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		20		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
		$V_A = 5 \text{ V}$, $V_B = 0 \text{ V}$, from zero scale to full scale, $\pm 0.5 \text{ LSB error band}$				
Crosstalk (C_{W1}/C_{W2})	C_T	$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		2		μs
		$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		12		μs
Analog Crosstalk	C_{TA}	$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		10		nV-sec
		$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		25		nV-sec
Endurance ¹⁰		$T_A = 25^\circ\text{C}$		1		Mcycles
Data Retention ¹¹			100			kcycles
				50		Years

¹ Typ 値は、 25°C および $V_{DD} = 5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ での平均測定値。

² 抵抗積分非直線性誤差(R-INL)は、最大抵抗ワイパー・ポジションと最小抵抗ワイパー・ポジションとの間で測定された理論値からの差を表します。R-DNLは、連続タップ・ポジション間での理論値からの相対的ステップ変化を表します。最大ワイパー電流は $(0.7 \times V_{DD})/R_{AB}$ に制限されています。

³ 設計およびキャラクタライゼーションで保証しますが、出荷テストは行いません。

⁴ INLとDNLは、RDACを電圧出力D/Aコンバータと同様のポテンショメータ分圧器として設定して、 V_{WB} で測定。 $V_A = V_{DD}$ かつ $V_B = 0 \text{ V}$ 。最大 $\pm 1 \text{ LSB}$ のDNL仕様規定値は単調動作状態を保証。

⁵ 抵抗ピンA、抵抗ピンB、抵抗ピンWの極性は相対的に制約されません。両電源動作では、グラウンドを基準としたバイポーラ信号の調整が可能です。

⁶ 動作電流とは異なり、EEPROM書込みの電源電流は約30ms継続します。

⁷ 動作電流とは異なり、EEPROM読出しの電源電流は約20 μs 継続します。

⁸ P_{DISS} は $(I_{DD} \times V_{DD})$ から計算。

⁹ すべてのダイナミック特性では $V_{DD}/V_{SS} = \pm 2.5 \text{ V}$ を使用。

¹⁰ 書込み可能回数は、JEDEC Std.22メソッドA117に基づき100,000サイクルで評価し、 $-40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ で測定。

¹¹ JEDEC Std. 22、メソッドA117に基づくジャンクション温度(T_J)=125 $^\circ\text{C}$ と等価。活性エネルギー1eVに基づくデータ保持寿命は、フラッシュ/EEメモリではジャンクション温度が上昇すると短くなります。

電気的特性—AD5143

特に指定がない限り、 $V_{DD} = 2.3\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0\text{ V}$ ； $V_{DD} = 2.25\text{ V} \sim 2.75\text{ V}$ 、 $V_{SS} = -2.25\text{ V} \sim -2.75\text{ V}$ ； $-40^\circ\text{C} < T_A < +125^\circ\text{C}$ 。

表 3.

Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	Min	Typ ¹	Max	Unit
DC CHARACTERISTICS—RHEOSTAT MODE (ALL RDACs)						
Resolution	N		8			Bits
Resistor Integral Nonlinearity ²	R-INL	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$ $V_{DD} \geq 2.7\text{ V}$	-2	± 0.2	+2	LSB
		$V_{DD} < 2.7\text{ V}$ $R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$ $V_{DD} \geq 2.7\text{ V}$	-5	± 1.5	+5	LSB
		$V_{DD} < 2.7\text{ V}$	-1	± 0.1	+1	LSB
Resistor Differential Nonlinearity ²	R-DNL		-2	± 0.5	+2	LSB
Nominal Resistor Tolerance	$\Delta R_{AB}/R_{AB}$		-8	± 1	+8	%
Resistance Temperature Coefficient ³	$(\Delta R_{AB}/R_{AB})/\Delta T \times 10^6$	Code = full scale		35		ppm/ $^\circ\text{C}$
Wiper Resistance ³	R_W	Code = zero scale $R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$		55	125	Ω
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		130	400	Ω
Bottom Scale or Top Scale	R_{BS} or R_{TS}	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$		40	80	Ω
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		60	230	Ω
Nominal Resistance Match	R_{AB1}/R_{AB2}	Code = 0xFF	-1	± 0.2	+1	%
DC CHARACTERISTICS—POTENTIOMETER DIVIDER MODE (ALL RDACs)						
Integral Nonlinearity ⁴	INL	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$	-1	± 0.2	+1	LSB
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$	-0.5	± 0.1	+0.5	LSB
Differential Nonlinearity ⁴	DNL		-0.5	± 0.2	+0.5	LSB
Full-Scale Error	V_{WFSE}	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$	-2.5	-0.1		LSB
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$	-1	± 0.2	+1	LSB
Zero-Scale Error	V_{WZSE}	$R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$		1.2	3	LSB
		$R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$		0.5	1	LSB
Voltage Divider Temperature Coefficient ³	$(\Delta V_W/V_W)/\Delta T \times 10^6$	Code = half scale		± 5		ppm/ $^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	Min	Typ ¹	Max	Unit
RESISTOR TERMINALS						
Maximum Continuous Current	$I_A, I_B, \text{ and } I_W$	$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$ $R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$	-6 -1.5		+6 +1.5	mA mA
Terminal Voltage Range ⁵			V_{SS}		V_{DD}	V
Capacitance A, Capacitance B ³	C_A, C_B	$f = 1 \text{ MHz}$, measured to GND, code = half scale $R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$ $R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		25 12		pF pF
Capacitance W ³	C_W	$f = 1 \text{ MHz}$, measured to GND, code = half scale $R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$ $R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		12 5		pF pF
Common-Mode Leakage Current ³		$V_A = V_W = V_B$	-500	± 15	+500	nA
DIGITAL INPUTS						
Input Logic ³						
High	V_{INH}		$0.7 \times V_{DD}$			V
Low	V_{INL}				$0.2 \times V_{DD}$	V
Input Hysteresis ³	V_{HYST}		$0.1 \times V_{DD}$			V
Input Current ³	I_{IN}				± 1	μA
Input Capacitance ³	C_{IN}			5		pF
DIGITAL OUTPUTS						
Output High Voltage ³	V_{OH}	$R_{PULL-UP} = 2.2 \text{ k}\Omega$ to V_{DD}		V_{DD}		V
Output Low Voltage ³	V_{OL}	$I_{SINK} = 3 \text{ mA}$ $I_{SINK} = 6 \text{ mA}$			0.4 0.6	V V
Three-State Leakage Current			-1		+1	μA
Three-State Output Capacitance				2		pF
POWER SUPPLIES						
Single-Supply Power Range		$V_{SS} = \text{GND}$	2.3		5.5	V
Dual-Supply Power Range			± 2.25		± 2.75	V
Positive Supply Current	I_{DD}	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$ $V_{DD} = 5.5 \text{ V}$ $V_{DD} = 2.3 \text{ V}$		0.7 400	5.5	μA nA
Negative Supply Current	I_{SS}	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$	-5.5	-0.7		μA
EEPROM Store Current ^{3,6}	$I_{DD_EEPROM_STORE}$	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$		2		mA
EEPROM Read Current ^{3,7}	$I_{DD_EEPROM_READ}$	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$		320		μA
Power Dissipation ⁸	P_{DISS}	$V_{IH} = V_{DD}$ or $V_{IL} = \text{GND}$		3.5		μW
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	$\Delta V_{DD}/\Delta V_{SS} = V_{DD} \pm 10\%$, code = full scale		-66	-60	dB

Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	Min	Typ ¹	Max	Unit
DYNAMIC CHARACTERISTICS ⁹						
Bandwidth	BW	-3 dB				
		$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		3		MHz
Total Harmonic Distortion	THD	$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		0.43		MHz
		$V_{DD}/V_{SS} = \pm 2.5 \text{ V}$, $V_A = 1 \text{ V rms}$, $V_B = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$				
Resistor Noise Density	e_{N_WB}	$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		-80		dB
		$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		-90		dB
V_W Settling Time	t_S	Code = half scale, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $f = 10 \text{ kHz}$				
		$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		7		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
V_W Settling Time	t_S	$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		20		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
		$V_A = 5 \text{ V}$, $V_B = 0 \text{ V}$, from zero scale to full scale, $\pm 0.5 \text{ LSB error band}$				
Crosstalk (C_{W1}/C_{W2})	C_T	$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		2		μs
		$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		12		μs
Analog Crosstalk	C_{TA}	$R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$		10		nV-sec
		$R_{AB} = 100 \text{ k}\Omega$		25		nV-sec
Endurance ¹⁰		$T_A = 25^\circ\text{C}$		1		Mcycles
Data Retention ¹¹			100			kcycles
				50		Years

¹ Typ 値は、 25°C および $V_{DD} = 5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ での平均測定値。

² 抵抗積分非直線性誤差(R-INL)は、最大抵抗ワイパー・ポジションと最小抵抗ワイパー・ポジションとの間で測定された理論値からの差を表します。R-DNLは、連続タップ・ポジション間での理論値からの相対的ステップ変化を表します。最大ワイパー電流は $(0.7 \times V_{DD})/R_{AB}$ に制限されています。

³ 設計およびキャラクタライゼーションで保証しますが、出荷テストは行いません。

⁴ INLとDNLは、RDACを電圧出力D/Aコンバータと同様のポテンショメータ分圧器として設定して、 V_{WB} で測定。 $V_A = V_{DD}$ かつ $V_B = 0 \text{ V}$ 。最大 $\pm 1 \text{ LSB}$ のDNL仕様規定値は単調動作状態を保証。

⁵ 抵抗ピンA、抵抗ピンB、抵抗ピンWの極性は相対的に制約されません。両電源動作では、グラウンドを基準としたバイポーラ信号の調整が可能です。

⁶ 動作電流とは異なり、EEPROM書込みの電源電流は約30ms継続します。

⁷ 動作電流とは異なり、EEPROM読出しの電源電流は約20 μs 継続します。

⁸ P_{DISS} は $(I_{DD} \times V_{DD})$ から計算。

⁹ すべてのダイナミック特性では $V_{DD}/V_{SS} = \pm 2.5 \text{ V}$ を使用。

¹⁰ 書込み可能回数は、JEDEC Std.22メソッドA117に基づき100,000サイクルで評価し、 $-40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ で測定。

¹¹ JEDEC Std. 22、メソッドA117に基づくジャンクション温度(T_J)=125 $^\circ\text{C}$ と等価。活性エネルギー1eVに基づくデータ保持寿命は、フラッシュ/EEメモリではジャンクション温度が上昇すると短くなります。

インターフェース・タイミング仕様

特に指定のない限り、 $V_{DD} = 2.3 \sim 5.5$ V;すべての仕様は $T_{MIN} \sim T_{MAX}$ で規定。

表 4. I²C インターフェース

Parameter ¹	Test Conditions/Comments	Min	Typ	Max	Unit	Description
f_{SCL} ²	Standard mode			100	kHz	Serial clock frequency
	Fast mode			400	kHz	
t_1	Standard mode	4.0			μ s	SCL high time, t_{HIGH}
	Fast mode	0.6			μ s	
t_2	Standard mode	4.7			μ s	SCL low time, t_{LOW}
	Fast mode	1.3			μ s	
t_3	Standard mode	250			ns	Data setup time, $t_{SU; DAT}$
	Fast mode	100			ns	
t_4	Standard mode	0		3.45	μ s	Data hold time, $t_{HD; DAT}$
	Fast mode	0		0.9	μ s	
t_5	Standard mode	4.7			μ s	Setup time for a repeated start condition, $t_{SU; STA}$
	Fast mode	0.6			μ s	
t_6	Standard mode	4			μ s	Hold time (repeated) for a start condition, $t_{HD; STA}$
	Fast mode	0.6			μ s	
t_7	Standard mode	4.7			μ s	Bus free time between a stop and a start condition, t_{BUF}
	Fast mode	1.3			μ s	
t_8	Standard mode	4			μ s	Setup time for a stop condition, $t_{SU; STO}$
	Fast mode	0.6			μ s	
t_9	Standard mode			1000	ns	Rise time of SDA signal, t_{RDA}
	Fast mode	$20 + 0.1 C_L$		300	ns	
t_{10}	Standard mode			300	ns	Fall time of SDA signal, t_{FDA}
	Fast mode	$20 + 0.1 C_L$		300	ns	
t_{11}	Standard mode			1000	ns	Rise time of SCL signal, t_{RCL}
	Fast mode	$20 + 0.1 C_L$		300	ns	
t_{11A}	Standard mode			1000	ns	Rise time of SCL signal after a repeated start condition and after an acknowledge bit, t_{RCL} (not shown in Figure 3)
	Fast mode	$20 + 0.1 C_L$		300	ns	
t_{12}	Standard mode			300	ns	Fall time of SCL signal, t_{FCL}
	Fast mode	$20 + 0.1 C_L$		300	ns	
t_{SP} ³	Fast mode	0		50	ns	Pulse width of suppressed spike (not shown in Figure 3)
$t_{EEPROM_PROGRAM}$ ⁴			15	50	ms	Memory program time (not shown in Figure 3)
$t_{EEPROM_READBACK}$			7	30	μ s	Memory readback time (not shown in Figure 3)
t_{POWER_UP} ⁵				75	μ s	Power-on EEPROM restore time (not shown in Figure 3)
t_{RESET}			30		μ s	Reset EEPROM restore time (not shown in Figure 3)

¹ 最大バス容量は 400 pF に制限されています。

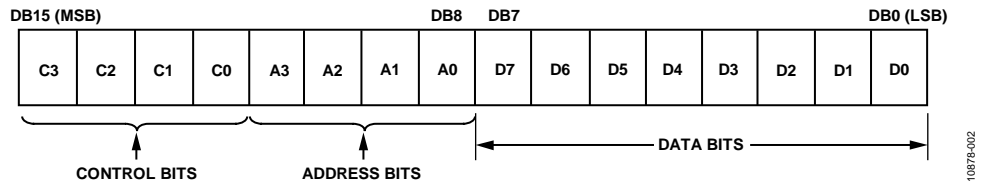
² SDA と SCL のタイミングは、入力フィルタをイネーブルして測定。入力フィルタを切り離すと、転送レートは向上しますが、デバイスの EMC 動作に悪影響があります。

³ SCL と SDA の入力フィルタリングにより、高速モードでノイズ・スパイクを 50 ns 以下に抑圧。

⁴ EEPROM 書込時間は、温度と EEPROM 書込みサイクル数に依存します。低温と長い書込みサイクルではタイミングが長くなると予測されます。

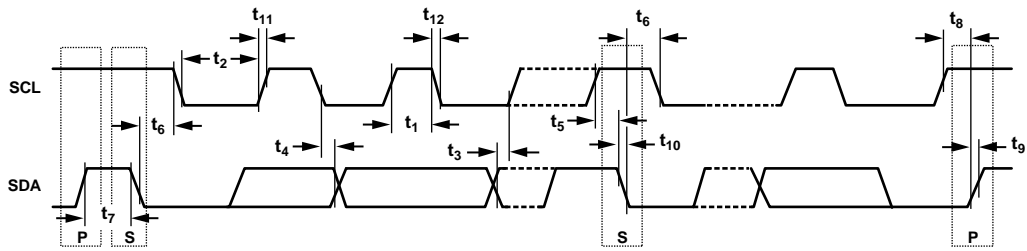
⁵ $V_{DD} - V_{SS}$ が 2.3 V に等しくなった後の最大時間。

シフトレジスタとタイミング図



10878-002

図 2.入力シフトレジスタ値



10878-003

図 3.I²C シリアル・インターフェースのタイミング図 (代表的な書込シーケンス)

絶対最大定格

特に指定のない限り、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 。

表 5.

Parameter	Rating
V_{DD} to GND	-0.3 V to +7.0 V
V_{SS} to GND	+0.3 V to -7.0 V
V_{DD} to V_{SS}	7 V
V_A , V_W , V_B to GND	$V_{SS} - 0.3\text{ V}$, $V_{DD} + 0.3\text{ V}$ or +7.0 V (whichever is less)
I_A , I_W , I_B Pulsed ¹	
Frequency > 10 kHz	
$R_{AW} = 10\text{ k}\Omega$	$\pm 6\text{ mA/d}^2$
$R_{AW} = 100\text{ k}\Omega$	$\pm 1.5\text{ mA/d}^2$
Frequency $\leq 10\text{ kHz}$	
$R_{AW} = 10\text{ k}\Omega$	$\pm 6\text{ mA}/\sqrt{d}^2$
$R_{AW} = 100\text{ k}\Omega$	$\pm 1.5\text{ mA}/\sqrt{d}^2$
Digital Inputs	-0.3 V to $V_{DD} + 0.3\text{ V}$ or +7 V (whichever is less)
Operating Temperature Range, T_A ³	-40°C to +125°C
Maximum Junction Temperature, T_J Maximum	150°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Reflow Soldering	
Peak Temperature	260°C
Time at Peak Temperature	20 sec to 40 sec
Package Power Dissipation	$(T_J \text{ max} - T_A)/\theta_{JA}$
ESD ⁴	4 kV
FICDM	1.5 kV

¹ 最大ピン電流は、スイッチの最大処理電流、パッケージ最大消費電力、Aピン、Bピン、Wピン内の任意の2ピン間の、設定された抵抗での最大入力電圧により制約されます。

² d = パルス・デューティ係数。

³ EEPROMメモリの書き込みを含みます。

⁴ 人体モデル (HBM)。

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格の規定のみを目的とするものであり、この仕様の動作のセクションに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。デバイスを長時間絶対最大定格状態に置くとデバイスの信頼性に影響を与えます。

熱抵抗

θ_{JA} は JEDEC JESD51 規格により定義され、値はテスト・ボードとテスト環境に依存します。

表 6.熱抵抗

Package Type	θ_{JA}	θ_{JC}	Unit
16-Lead LFCSP	89.5 ¹	3	°C/W

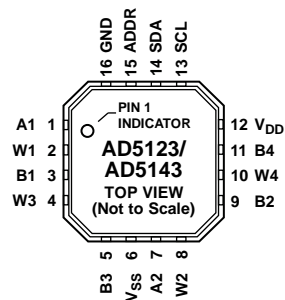
¹ JEDEC 2S2P テスト・ボード、自然空冷(0 m/sec の空気流)。

ESD の注意



ESD (静電放電) の影響を受けやすいデバイスです。電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されないまま放電することがあります。本製品は当社独自の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措置を講じることをお勧めします。

ピン配置およびピン機能説明



NOTES
1. INTERNALLY CONNECT THE EXPOSED PAD TO V_{SS} .

10875-004

図 4. ピン配置

表 7. ピン機能の説明

ピン番号	記号	説明
1	A1	RDAC1 のピン A。 $V_{SS} \leq V_A \leq V_{DD}$ 。
2	W1	RDAC1 のワイパー・ピン。 $V_{SS} \leq V_W \leq V_{DD}$ 。
3	B1	RDAC1 のピン B。 $V_{SS} \leq V_B \leq V_{DD}$ 。
4	W3	RDAC3 のワイパー・ピン。 $V_{SS} \leq V_W \leq V_{DD}$ 。
5	B3	RDAC3 のピン B。 $V_{SS} \leq V_B \leq V_{DD}$ 。
6	V_{SS}	負の電源。このピンは、0.1 μ F のセラミック・コンデンサと 10 μ F のコンデンサでデカップリングする必要があります。
7	A2	RDAC2 のピン A。 $V_{SS} \leq V_A \leq V_{DD}$ 。
8	W2	RDAC2 のワイパー・ピン。 $V_{SS} \leq V_W \leq V_{DD}$ 。
9	B2	RDAC2 のピン B。 $V_{SS} \leq V_B \leq V_{DD}$ 。
10	W4	RDAC4 のワイパー・ピン。 $V_{SS} \leq V_W \leq V_{DD}$ 。
11	B4	RDAC4 のピン B。 $V_{SS} \leq V_B \leq V_{DD}$ 。
12	V_{DD}	正の電源。このピンは、0.1 μ F のセラミック・コンデンサと 10 μ F のコンデンサでデカップリングする必要があります。
13	SCL	シリアル・クロック・ライン。データは、立下がり変化で入力されます。
14	SDA	シリアル・データ入力/出力。
15	ADDR	複数のパッケージをデコードするためのプログラマブルなアドレス。
16	GND	グラウンド・ピン、ロジック・グラウンド基準。
	EPAD	エクスポーズド・パッドは内部で V_{SS} へ接続されています。

代表的な性能特性

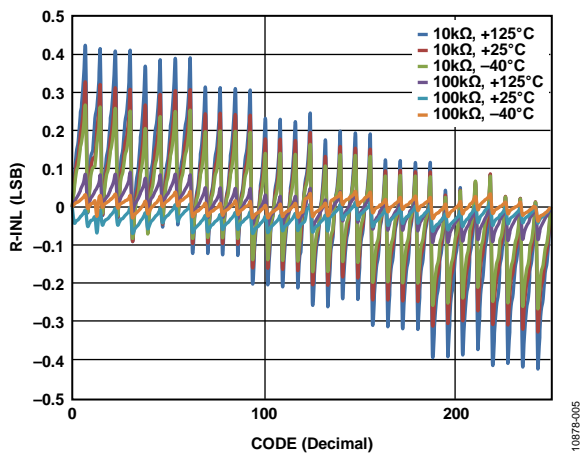


図 5.コード対 R-INL (AD5143)

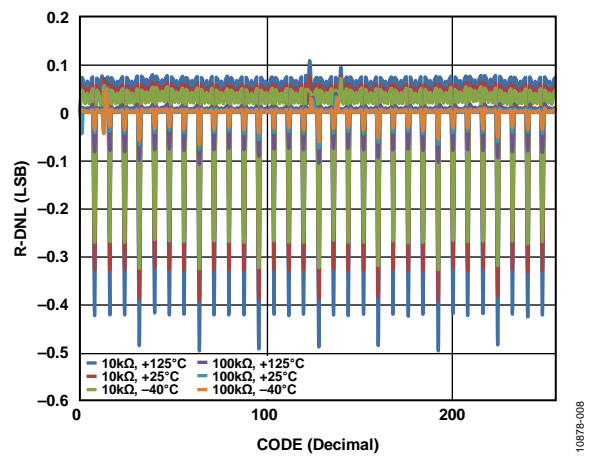


図 8.コード対 R-DNL (AD5143)

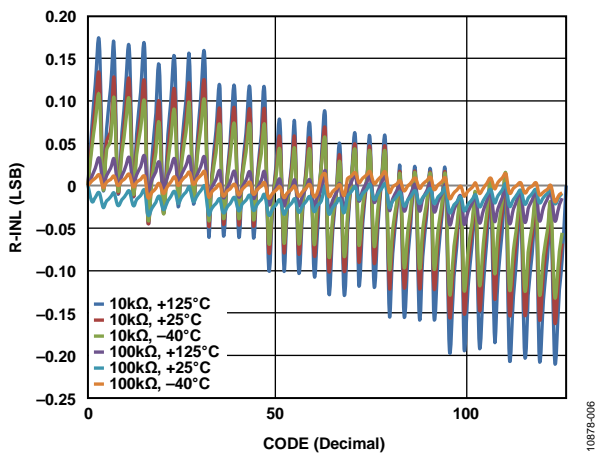


図 6.コード対 R-INL (AD5123)

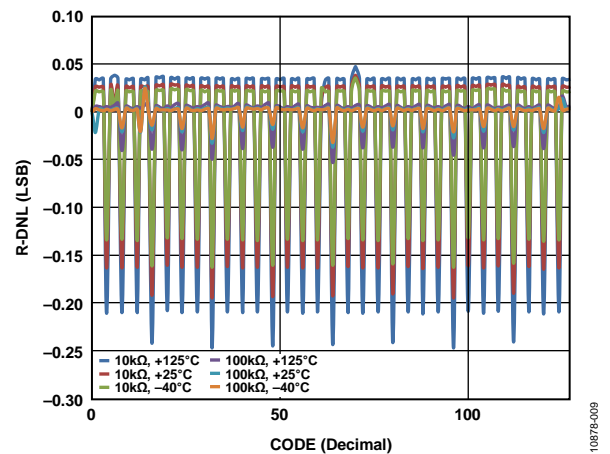


図 9.コード対 R-DNL (AD5123)

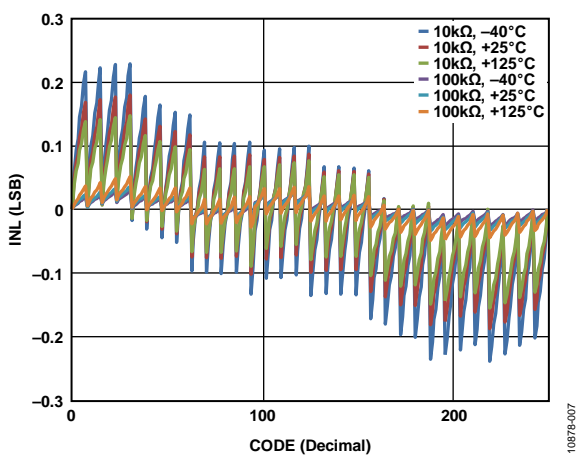


図 7.コード対 INL (AD5143)

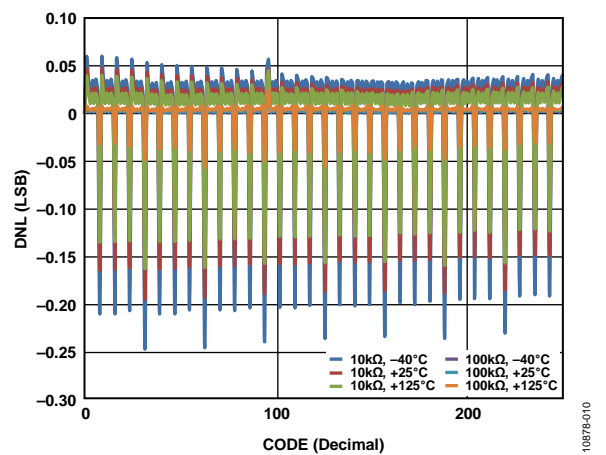


図 10.コード対 DNL (AD5143)

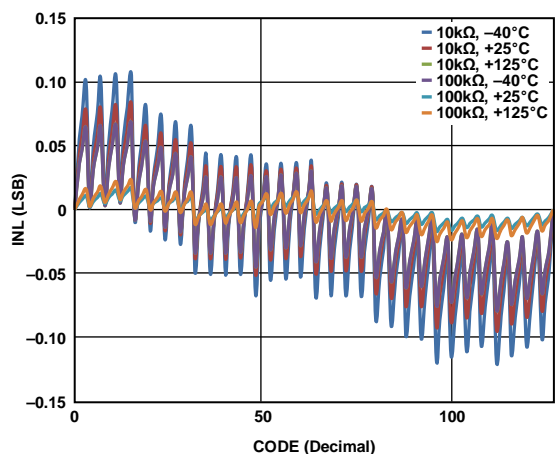


図 11.コード対 INL (AD5123)

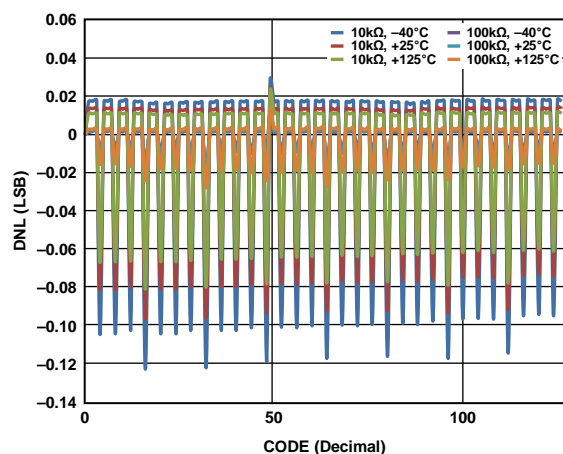


図 14.コード対 DNL (AD5123)

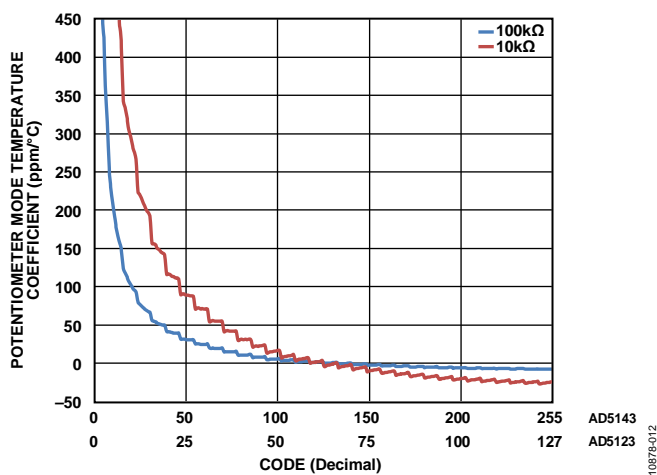


図 12.コード対ポテンショメータ・モード温度係数 $((\Delta V_W/V_W)/\Delta T \times 10^6)$

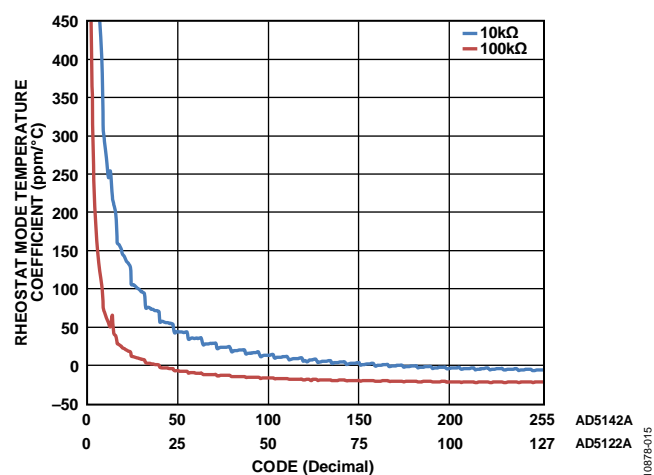


図 15.コード対可変抵抗器モード温度係数 $((\Delta R_{WB}/R_{WB})/\Delta T \times 10^6)$

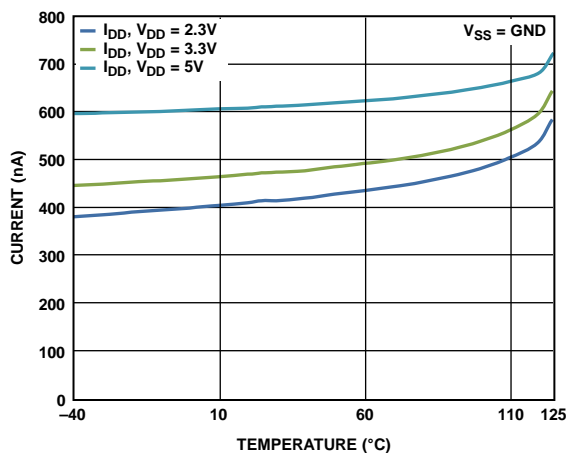


図 13.電源電流の温度特性

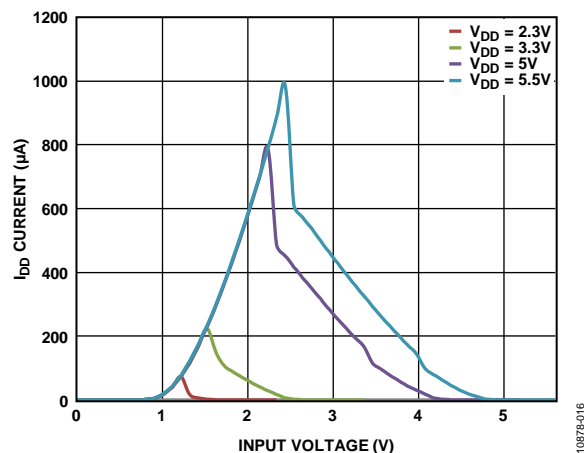


図 16.デジタル入力電圧対 I_{DD} 電流

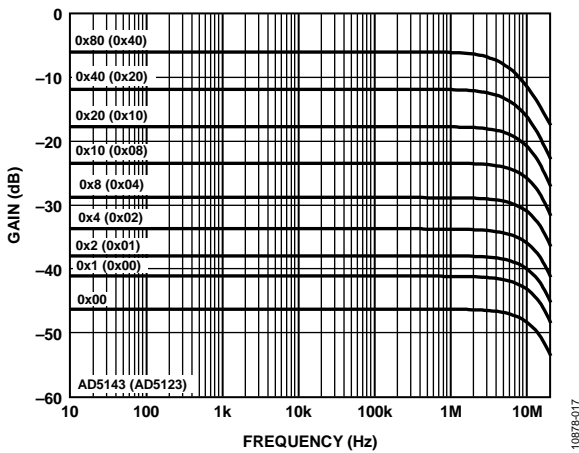


図 17. 10kΩ ゲイン対周波数特性対コード

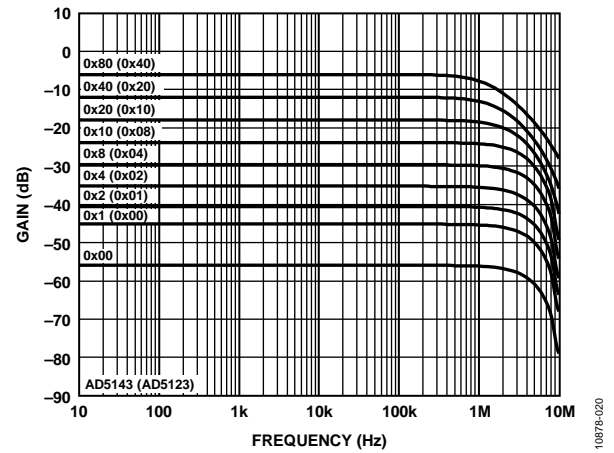


図 20. 100kΩ ゲイン対周波数特性対コード

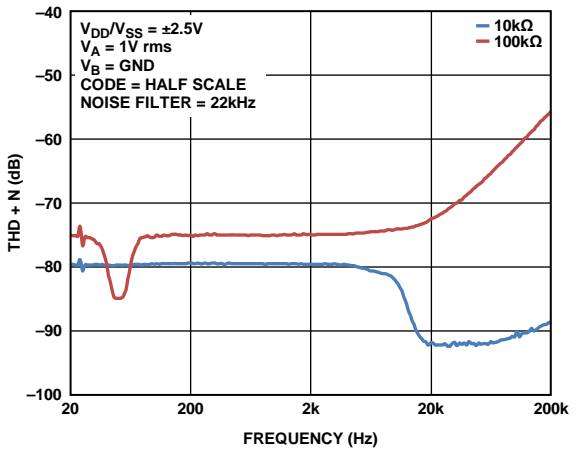


図 18. 総合高調波歪み + ノイズ (THD + N) の周波数特性

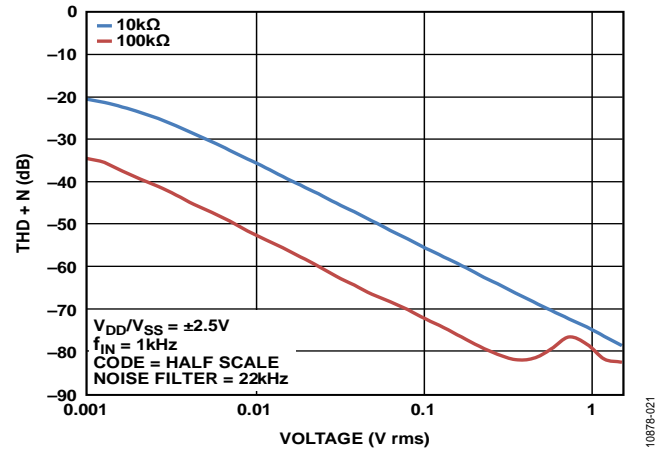


図 21. 振幅対総合高調波歪み + ノイズ (THD + N)

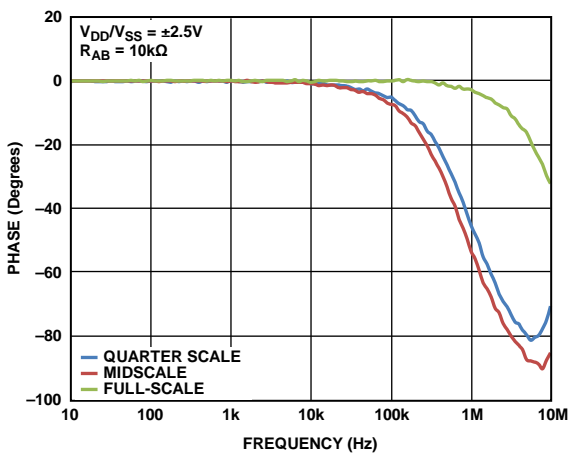


図 19. 正規化位相平坦性の周波数特性、 $R_{AB} = 10\text{ k}\Omega$

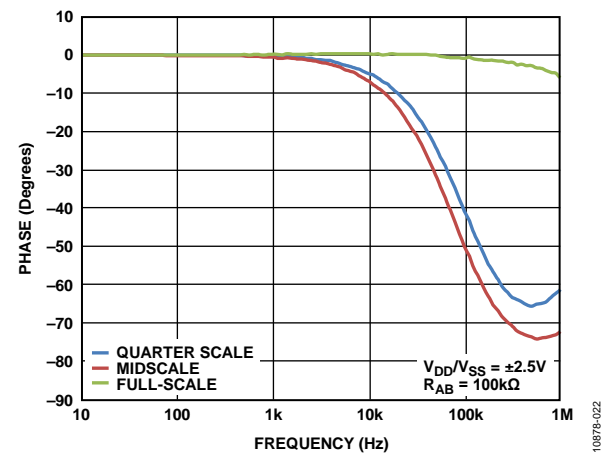


図 22. 正規化位相平坦性の周波数特性、 $R_{AB} = 100\text{ k}\Omega$

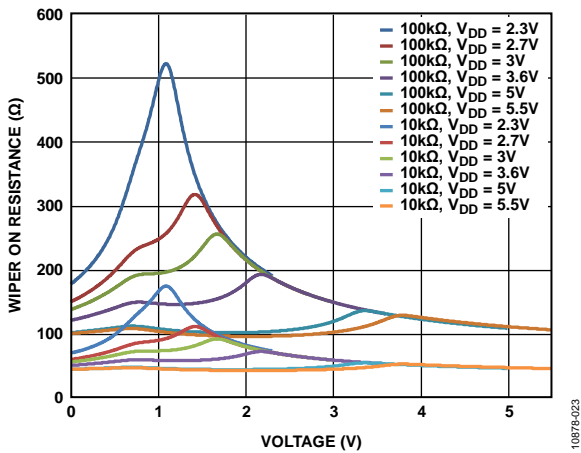


図 23.正電源 V_{DD} 対インクリメンタル・ワイパーオン抵抗

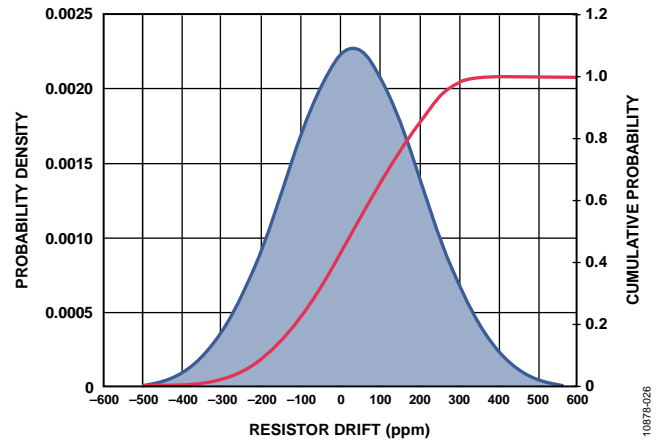


図 26.抵抗寿命ドリフト

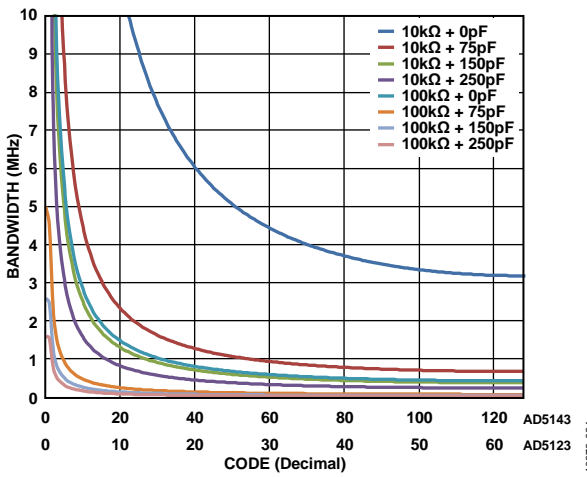


図 24.最大帯域幅対コード対容量

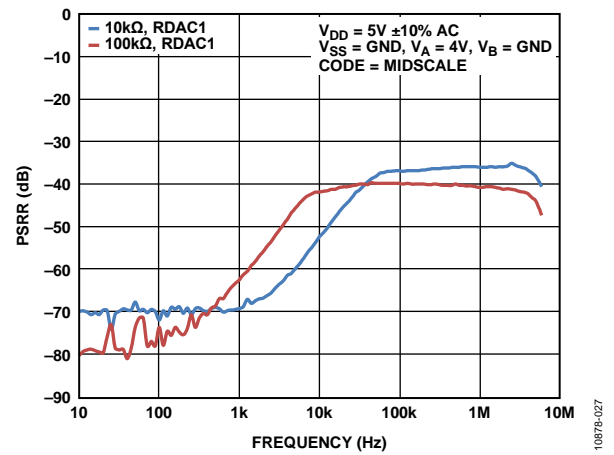


図 27.電源除去比(PSRR)の周波数特性

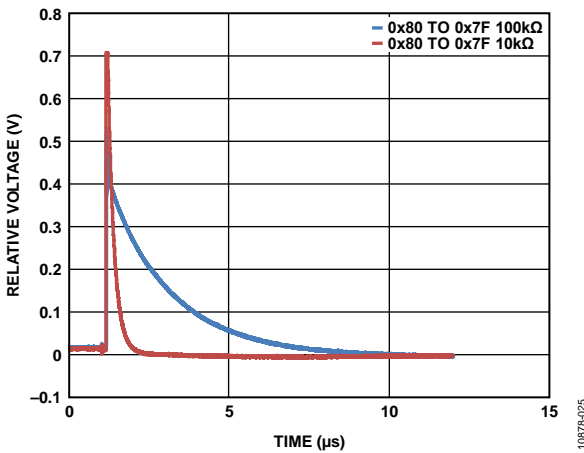


図 25.変化時最大グリッチ

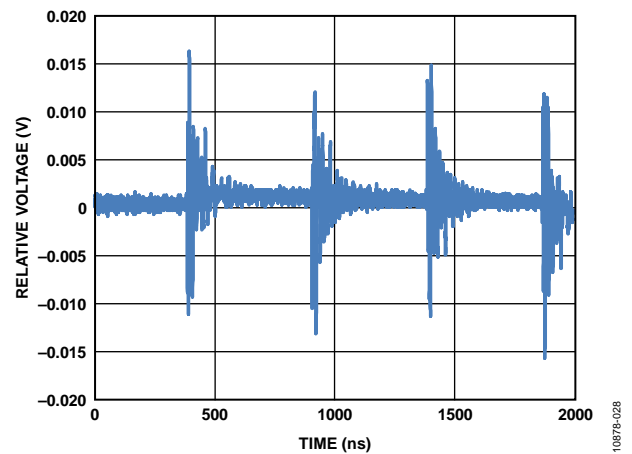


図 28.デジタル・フィードスルー

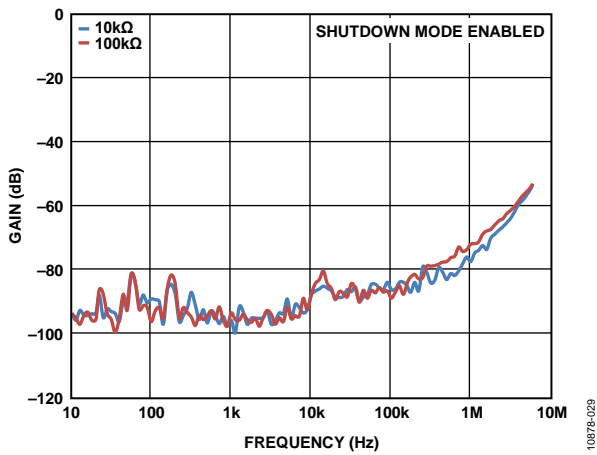


図 29. シャットダウン・アイソレーションの周波数特性

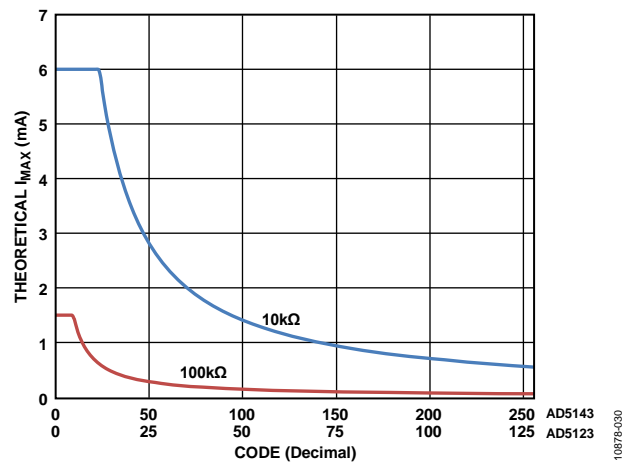


図 30. コード対理論最大電流

テスト回路

図 31 ~ 図 35 に、仕様のセクションで使用したテスト条件を示します。

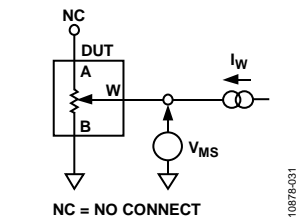


図 31. 抵抗積分非直線性誤差 (可変抵抗器動作; R-INL、R-DNL)

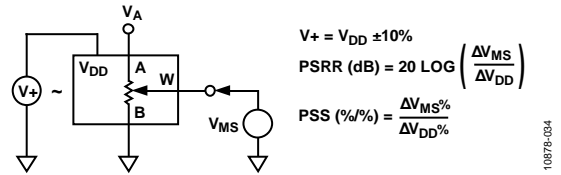


図 34. 電源感度と電源除去比 (PSS、PSRR)

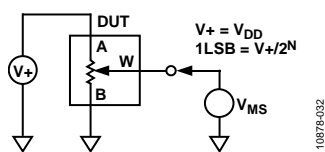


図 32. ポテンショメータ分圧器の非直線性誤差(INL、DNL)

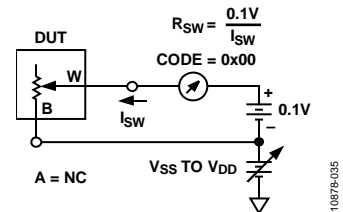


図 35. オン抵抗増分

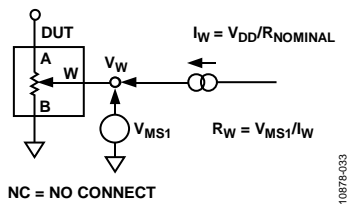


図 33. ワイパー抵抗

動作原理

AD5123/AD5143 デジタル・プログラマブル・ポテンショメータは、 $V_{SS} < V_{TERM} < V_{DD}$ のピン電圧範囲内のアナログ信号に対して真の可変抵抗として動作するようにデザインされています。抵抗のワイパー・ポジションは、RDAC レジスタの値により決定されます。RDAC レジスタはスクラッチパッド・レジスタのように動作するため、抵抗設定値の変更回数には制限がありません。2つ目のレジスタ(入力レジスタ)は、RDAC レジスタ・データを予めロードしておくために使うことができます。

RDAC レジスタには、 I^2C インターフェース(モデルにより)を介して任意のポジション設定値を書込むことができます。目的のワイパー・ポジションが見つかった後に、この値をEEPROM メモリに保存することができます。それ以後、ワイパー・ポジションは、後続パワーアップで常にそのポジションに回復されます。EEPROM データの保存には約 15 ms 要し、この間デバイスがロックされて、新しいコマンドをアクノリッジしないため、値の変更が防止されます。

RDAC レジスタと EEPROM

RDAC レジスタは、デジタル・ポテンショメータのワイパー・ポジションを直接制御します。例えば、RDAC レジスタに 0x80 をロードすると(AD5143、256 タップ)、ワイパーは可変抵抗の 1/2 スケールに接続されます。RDAC レジスタは標準のロジック・レジスタであるため、許容変更回数には制限がありません。デジタル・インターフェース(表 9 参照)を使って RDAC レジスタの書込みと読出しを行うことができます。

RDAC レジスタ値は、コマンド 9 を使って EEPROM へ保存することができます(表 9 参照)。その後、RDAC レジスタは、その後の ON-OFF-ON 電源シーケンスでそのポジションに常に設定されます。EEPROM に保存されたデータはコマンド 3 を使ってリードバックすることができます(表 9 参照)。

あるいは、コマンド 11 を使って EEPROM へ独立に書込むことができます(表 15 参照)。

入力シフトレジスタ

AD5123/AD5143 の入力シフトレジスタは、図 2 に示すように 16 ビット幅です。各 16 ビット・ワードは、4 ビットのコントロール・ビットとその後ろに続く 4 ビットのアドレス・ビットと 8 ビットのデータビットにより構成されます。

AD5143 の RDAC または EEPROM レジスタに対して書込/読出しを行う場合、最下位ビット(ビット 0)は無視されます。データは MSB ファースト(ビット 15)でロードされます。表 9 と表 15 に示すように、4 ビットのコントロール・ビットにより、ソフトウェア・コマンドの機能が指定されます。

I^2C シリアル・データ・インターフェース

AD5123/AD5143 は、2 線式の I^2C 互換シリアル・インターフェースを内蔵しています。これらのデバイスは、マスター・デバイスから制御されるスレーブ・デバイスとして I^2C バスに接続することができます。図 3 に、代表的な書込みシーケンスのタイミング図を示します。

AD5123/AD5143 は、標準(100 kHz)と高速(400 kHz)のデータ転送モードをサポートしています。10 ビット・アドレッシングとジェネラル・コール・アドレッシングはサポートされていません。

2 線式シリアル・バス・プロトコルは、次のように動作します。

1. マスターはスタート条件を設定してデータ転送を開始します。このスタート条件は、SCLがハイ・レベルの間にSDAラインがハイ・レベルからロー・レベルへ変化することと定義されます。次のバイトはアドレス・バイトで、7ビットのスレーブ・アドレスとR/Wビットから構成されています。送信されたアドレスに該当するスレーブ・デバイスは9番目のクロック・パルスで、SDAラインをロー・レベルにして応答します(これはアクノリッジ・ビットと呼ばれます)。選択されたデバイスがシフトレジスタに読み書きするデータを待つ間、バス上の他の全デバイスはアイドル状態を維持します。R/Wビットがハイ・レベルの場合は、マスターがスレーブ・デバイスから読出しを行います。R/Wビットがロー・レベルの場合は、マスターがスレーブ・デバイスに対して書込みを行います。
2. データは、9個のクロック・パルスで8ビットのデータとそれに続くアクノリッジ・ビットの順にシリアル・バス上を伝送します。SDAラインはSCLのロー・レベル区間で変化して、SCLのハイ・レベル区間で安定に維持されている必要があります。
3. 全データビットの読出しまたは書込みが終了すると、ストップ条件が設定されます。書込みモードでは、マスターが10番目のクロック・パルスでSDAラインをハイ・レベルにプルアップして、ストップ状態を設定します。読出しモードでは、マスターは9番目のクロック・パルスでアクノリッジを発行しません(SDAラインがハイ・レベルを維持)。この後、マスターはSDAラインをロー・レベルにして、10番目のクロック・パルスが再度ハイ・レベルになるときストップ条件を設定します。

I^2C アドレス

ADDR をハード・ワイヤー接続で固定的に変更する機能を使うと、表 8 に示すように、1つのバスにこれらのデバイスを最大 3 個接続することができます。

表 8. I^2C アドレスの選択

ADDR Pin	7-Bit I^2C Device Address
V_{DD}	0101000
No connect ¹	0101010
GND	0101011

¹ バイポーラ・モード ($V_{SS} < 0V$) では使用できません。

表 9.簡素化コマンド動作の真理値表

Command Number	Control Bits[DB15:DB12]				Address Bits[DB11:DB8] ¹				Data Bits[DB7:DB0] ¹								Operation		
	C3	C2	C1	C0	A3	A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NOP: do nothing		
1	0	0	0	1	0	0	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Write contents of serial register data to RDAC		
2	0	0	1	0	0	0	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Write contents of serial register data to input register		
3	0	0	1	1	0	0	A1	A0	X	X	X	X	X	X	D1	D0	Read back contents		
																	D1	D0	Data
																	0	1	EEPROM
																	1	1	RDAC
9	0	1	1	1	0	0	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	1	Copy RDAC register to EEPROM	
10	0	1	1	1	0	0	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	Copy EEPROM into RDAC	
14	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Software reset	
15	1	1	0	0	A3	0	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	D0	Condition	
																	D0	Condition	
																	0	Normal mode	
																		1	Shutdown mode

¹ X = don't care

表 10.簡素化アドレス・ビットの真理値表

A3	A2	A1	A0	Channel	Stored Channel Memory
1	X ¹	X ¹	X ¹	All channels	Not applicable
0	0	0	0	RDAC1	RDAC1
0	0	0	1	RDAC2	RDAC2
0	0	1	0	RDAC3	RDAC3
0	0	1	1	RDAC4	RDAC4

¹ X = don't care

高度な制御モード

AD5123/AD5143 デジタル・ポテンショメータは、これらの汎用的な調整デバイスで使用可能な広範囲なアプリケーションに対応できるユーザー・プログラミング機能のセットを内蔵しています(表 15 と表 17 参照)。

主要なプログラミング機能としては次の内容が含まれます。

- 入力レジスタ
- リニア・ゲイン設定モード
- 低ワイパー抵抗機能
- リニア・インクリメントおよびデクリメント命令
- ± 6 dB のインクリメントおよびデクリメント命令
- バースト・モード (I²C の場合)
- リセット
- シャットダウン・モード

入力レジスタ

AD5123/AD5143 は、RDAC レジスタごとに 1 個の入力レジスタを持っています。これらレジスタを使うと、対応する RDAC レジスタの値を予めロードしておくことができます。これらのレジスタに対しては、コマンド 2 を使って書込ができ、コマンド 3 を使ってリードバックすることができます(表 15 参照)。

この機能を使うと、1 個またはすべての RDAC レジスタを同時に同期または非同期で更新することができます。

入力レジスタから RDAC レジスタへの転送は、コマンド 8 を使って同期的に行うことができます(表 15 参照)。

新しいデータを RDAC レジスタへロードすると、この RDAC レジスタは自動的に対応する入力レジスタを上書きします。

リニア・ゲイン設定モード

AD5123/AD5143 の特許取得済みのアーキテクチャにより、各ストリング抵抗 R_{AW} と R_{WB} の独立な制御が可能です。この機能をイネーブルするときは、コマンド 16 (表 15 参照) を使って、コントロール・レジスタのビット D2 をセットします(表 17 参照)。

この動作モードでは、一点 W ピンで接続された 2 個の独立な可変抵抗器としてポテンショメータを制御することができます。

これに対して、ポテンショメータ・モードでは各抵抗は $R_{AW} = R_{AB} - R_{WB}$ として相補的になります。

このモードでは、チャンネルごとに 2 つ目の入力と RDAC レジスタが可能になりますが(表 16 参照)、実際の RDAC 値は不変に維持されます。同じ動作が、ポテンショメータ・モードとリニア・ゲイン設定モードで可能です。リセットまたはパワーオンの後、デバイスはポテンショメータ・モードに戻ります。

低ワイパー抵抗機能

AD5123/AD5143 には、フルスケールまたはゼロスケールを実現するときピン間のワイパー抵抗を小さくする 2 つのコマンドがあります。これらの追加ポジションは、ボトムスケール BS とトップスケール TS と呼ばれます。トップスケールでのピン A とピン W の間の抵抗は R_{TS} で規定されます。同様に、ピン B とピン W の間のボトムスケール抵抗は R_{BS} で規定されます。

RDAC レジスタ値は、これらのポジションになっても変化しません。トップスケールとボトムスケールから抜け出す方法は 3 つあります。1 つ目はコマンド 12 またはコマンド 13 を使う方法です(表 15 参照)。2 つ目は新しいデータを RDAC レジスタへロードする方法で、インクリメント/デクリメント動作とシャットダウン・コマンドを使います。3 つ目はシャットダウン・モード(コマンド 15)を使う方法です(表 15 参照)。

表 11 と表 12 に、ポテンショメータ・モードまたはリニア・ゲイン設定モードをイネーブルしたときの、それぞれトップスケール・ポジションとボトムスケール・ポジションの真理値表を示します。

表 11. トップスケールの真理値表

Linear Gain Setting Mode		Potentiometer Mode	
R_{AW}	R_{WB}	R_{AW}	R_{WB}
R_{AB}	R_{AB}	R_{TS}	R_{AB}

表 12. ボトムスケールの真理値表

Linear Gain Setting Mode		Potentiometer Mode	
R_{AW}	R_{WB}	R_{AW}	R_{WB}
R_{TS}	R_{BS}	R_{AB}	R_{BS}

連続なインクリメント命令とデクリメント命令

インクリメント・コマンドとデクリメント・コマンド(表 15 のコマンド 4 とコマンド 5)は、連続なステップ調整アプリケーションに便利です。これらのコマンドは、デバイスに対してインクリメントまたはデクリメント・コマンドをコントローラから送信させるだけで済むため、マイクロコントローラのソフトウェア・コーディングが簡単になります。調整は個々のポテンショメータごとに、または両ワイパー・ポジションを同時に変更するポテンショメータ・グループで行うことができます。

インクリメント・コマンドの場合、コマンド 4 を実行すると、ワイパーが自動的に次の抵抗 RDAC ポジションに移動します。このコマンドは、シングル・チャンネルまたは複数チャンネルで実行することができます。

±6 dB のインクリメントおよびデクリメント命令

2種類のプログラミング命令により、ワイパー・ポジション制御の対数傾きインクリメントと対数傾きデクリメントを、個別ポテンシオメータごとに、または全RDACレジスタ・ポジションを同時に変更するポテンシオメータ・グループごとに行います。+6 dBインクリメントはコマンド6により、-6 dBデクリメントはコマンド7により、それぞれ実行されます(表15参照)。例えば、ゼロスケール・ポジションから初めて、コマンド6を10回実行すると、6 dBステップでワイパーがフルスケール・ポジションまで移動します。ワイパー・ポジションが最大設定値に近づくと、最後の6 dBインクリメント命令でワイパーがフルスケール・ポジションに移動します(表13参照)。

ワイパー・ポジションを+6 dBだけインクリメントすると、RDACレジスタ値が2倍にされます。-6 dBだけデクリメントすると、レジスタ値が1/2倍されます。内部的には、AD5123/AD5143はシフトレジスタを使って、ビットを左と右にシフトして±6 dBのインクリメントまたはデクリメントを実現します。これらの機能は、様々なオーディオ/ビデオ・レベルの調節や、特に小さな調節より大きな調節に敏感な人の視覚応答での白色LED輝度の設定に便利です。

表 13. ±6dB ステップ・インクリメントとデクリメントの詳しい左および右シフト機能

Left Shift (+6 dB/Step)	Right Shift (-6 dB/Step)
0000 0000	1111 1111
0000 0001	0111 1111
0000 0010	0011 1111
0000 0100	0001 1111
0000 1000	0000 1111
0001 0000	0000 0111
0010 0000	0000 0011
0100 0000	0000 0001
1000 0000	0000 0000
1111 1111	0000 0000

バースト・モード

バースト・モードをイネーブルすると、複数のデータバイトを連続的にデバイスへ送ることができます。コマンド・バイトの後ろの連続バイトは、コマンドのデータバイトとして解釈されず。

新しいコマンドは、繰り返しスタートを発生するか、またはストップおよびスタート条件によって送信することができます。コントロール・レジスタのビット D3 をセットすると、バースト・モードがアクティブになります(表 17 参照)。

リセット

コマンド 14 を実行すると、ソフトウェアから AD5123/AD5143 をリセットすることができます(表 15 参照)。リセット・コマンドは、EEPROM 値を RDAC レジスタへロードし、約 30 μs を要します。EEPROM には出荷時にミッドスケールがロードされているため、初期パワーアップ時はミッドスケールになります。

シャットダウン・モード

ソフトウェア・シャットダウン・コマンドのコマンド 15 (表 15 参照)を実行して、LSB (D0)に 1 を設定することにより、AD5123/AD5143 をシャットダウンさせることができます。この機能により RDAC はゼロ消費電力状態になり、この状態ではデバイスはポテンシオメータ・モードで動作し、ピン A は開放になり、ワイパー・ピン W はピン B に接続されますが、有限なワイパー抵抗は 40 Ω になります。デバイスがリニア・ゲイン設定モードに設定されると、指定された抵抗(R_{AW} または R_{WB})が内部で高インピーダンス状態になります。表 14 に、デバイス動作モードに応じた真理値表を示します。RDAC レジスタ値はシャットダウン・モードになっても変化しませんが、シャットダウン・モードでは表 15 に示すすべてのコマンドがサポートされています。シャットダウン・モードを終了するときは、コマンド 15 (表 15 参照) を実行して、さらに LSB (D0)に 0 を設定します。

表 14. シャットダウン・モードの真理値表

Linear Gain Setting Mode		Potentiometer Mode	
R_{AW}	R_{WB}	R_{AW}	R_{WB}
High impedance	High impedance	High impedance	R_{BS}

EEPROM または RDAC レジスタの保護

これらのレジスタの更新をディスエーブルすることにより EEPROM と RDAC レジスタを保護することができます。これはソフトウェアまたはハードウェアにより行うことができます。ソフトウェアからこれらのレジスタを保護する場合は、ビット D0 および/またはビット D1 (表 17 参照)をセットします。これにより、RDAC レジスタと EEPROM レジスタが独立に保護されます。

RDAC 保護中に可能な唯一の動作は、EEPROM を RDAC レジスタへコピーすることだけです。

表 15. 高度なコマンド動作の真理値表

Command Number	Control Bits[DB15:DB12]				Address Bits[DB11:DB8] ¹				Data Bits[DB7:DB0] ¹								Operation		
	C3	C2	C1	C0	A3	A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NOP: do nothing		
1	0	0	0	1	A3	A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Write contents of serial register data to RDAC		
2	0	0	1	0	A3	A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Write contents of serial register data to input register		
3	0	0	1	1	X	A2	A1	A0	X	X	X	X	X	X	D1	D0	Read back contents		
																	D1	D0	Data
																	0	0	Input register
																	0	1	EEPROM
																	1	0	Control register
1	1	RDAC																	
4	0	1	0	0	A3	A2	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	1	Linear RDAC increment	
5	0	1	0	0	A3	A2	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	Linear RDAC decrement	
6	0	1	0	1	A3	A2	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	1	+6 dB RDAC increment	
7	0	1	0	1	A3	A2	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-6 dB RDAC decrement	
8	0	1	1	0	A3	A2	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Copy input register to RDAC (software LRDAC)	
9	0	1	1	1	0	0	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	1	Copy RDAC register to EEPROM	
10	0	1	1	1	0	0	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	Copy EEPROM into RDAC	
11	1	0	0	0	0	0	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Write contents of serial register data to EEPROM		
12	1	0	0	1	A3	A2	A1	A0	1	X	X	X	X	X	X	X	D0	Top scale	
																		D0 = 0; normal mode D0 = 1; shutdown mode	
13	1	0	0	1	A3	A2	A1	A0	0	X	X	X	X	X	X	X	D0	Bottom scale	
																		D0 = 1; enter D0 = 0; exit	
14	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Software reset	
15	1	1	0	0	A3	A2	A1	A0	X	X	X	X	X	X	X	X	D0	Software shutdown	
																		D0 = 0; normal mode D0 = 1; device placed in shutdown mode	
16	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	D3	D2	D1	D0	Copy serial register data to control register			

¹ X = don't care

表 16. アドレス・ビット

A3	A2	A1	A0	Potentiometer Mode		Linear Gain Setting Mode		Stored RDAC Memory
				Input Register	RDAC Register	Input Register	RDAC Register	
1	X ¹	X ¹	X ¹	All channels	All channels	All channels	All channels	Not applicable
0	0	0	0	RDAC1	RDAC1	R _{WB1}	R _{WB1}	RDAC1
0	1	0	0	Not applicable	Not applicable	R _{AW1}	R _{AW1}	Not applicable
0	0	0	1	RDAC2	RDAC2	R _{WB2}	R _{WB2}	RDAC2
0	1	0	1	Not applicable	Not applicable	R _{AW2}	R _{AW2}	Not applicable
0	0	1	0	RDAC3	RDAC3	R _{WB3}	R _{WB3}	RDAC3
0	1	1	0	Not applicable	Not applicable	R _{AW3}	R _{AW3}	Not applicable
0	0	1	1	RDAC4	RDAC4	R _{WB4}	R _{WB4}	RDAC4
0	1	1	1	Not applicable	Not applicable	R _{AW4}	R _{AW4}	Not applicable

¹ X = don't care

表 17.コントロール・レジスタ・ビットの説明

Bit Name	Description
D0	RDAC register write protect 0 = wiper position frozen to value in EEPROM memory 1 = allows update of wiper position through digital interface (default)
D1	EEPROM program enable 0 = EEPROM program disabled 1 = enables device for EEPROM program (default)
D2	Linear setting mode/potentiometer mode 0 = potentiometer mode (default) 1 = linear gain setting mode
D3	Burst mode 0 = disabled (default) 1 = enabled (no disable after stop or repeat start condition)

RDAC アーキテクチャ

最適性能を実現するため、アナログ・デバイセズはすべてのデジタル・ポテンショメータに対して特許取得済みの RDAC セグメント化アーキテクチャを採用しています。特に、AD5123/AD5143 では 3 ステージ・セグメント化を採用しています(図 36 参照)。

AD5123/AD5143 ワイパー・スイッチは、トランスミッション・ゲート CMOS 回路を採用してデザインされており、ゲート電圧は V_{DD} と V_{SS} から発生しています。

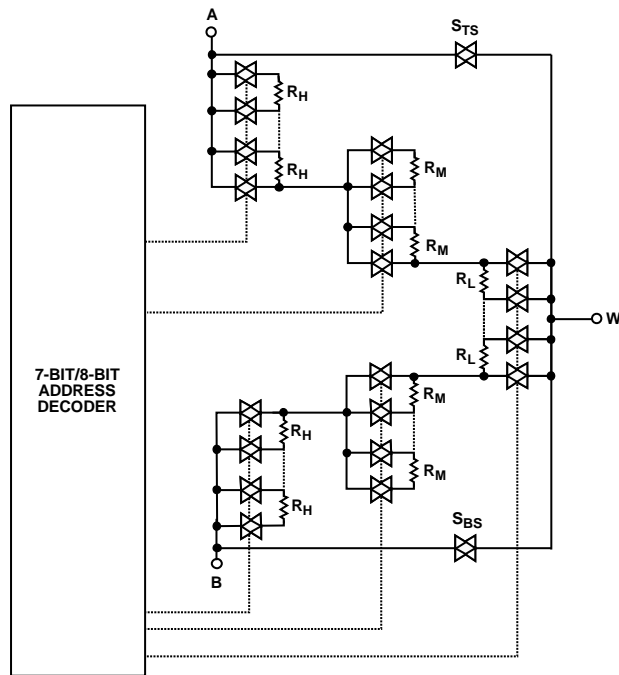


図 36. AD5123/AD5143 の簡略化した RDAC 回路

トップスケール/ボトムスケール・アーキテクチャ

さらに、AD5123/AD5143 はピン間の抵抗を小さくする新しいポジションを持っています。これらの追加ポジションは、ボトムスケールおよびトップスケールと呼ばれます。ボトムスケールでは、ワイパー抵抗 (typ) は $130\ \Omega$ から $60\ \Omega$ へ減少しています ($R_{AB} = 100\ k\Omega$)。トップスケールでは、ピン A とピン W の間の抵抗は 1 LSB 減少して、合計抵抗は $60\ \Omega$ に減少しています ($R_{AB} = 100\ k\Omega$)。

可変抵抗のプログラミング

可変抵抗器動作 $\pm 8\%$ 抵抗許容誤差

2本のピンを1つの可変抵抗として使用すると、AD5123/AD5143 は可変抵抗器モードで動作します。未使用ピンはフローティングのままか、ピン W へ接続しておくことができます(図 37 参照)。

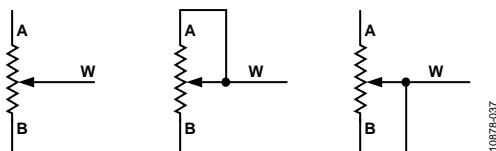


図 37. 可変抵抗器モードの構成

ピン A とピン B の間の公称抵抗 R_{AB} は $10\ k\Omega$ または $100\ k\Omega$ で、ワイパー・ピンからアクセスされる $128/256$ 個のタップ・ポイントを持っています。RDAC ラッチ内の $7/8$ ビット・データがデコードされて、 $128/256$ 通りのワイパー設定値を選択します。デジタル的にプログラムしたピン W とピン B の間の出力抵抗を決定する一般式は、次のようになります。

AD5123:

$$D_{4(6)} = \frac{6}{128} \times D_{34} + D_7 \quad 0x00 \sim 0x7F \quad (1)$$

AD5143:

$$D_{4(6)} = \frac{6}{256} \times D_{34} + D_7 \quad 0x00 \sim 0xFF \quad (2)$$

ここで、

D は、 $7/8$ ビット RDAC レジスタにロードされるバイナリ・コード・データの 10 進数表示。

R_{AB} はピン間抵抗。

R_W はワイパー抵抗。

ポテンショメータ・モードでは、機械的ポテンショメータと同様に、ピン W とピン A の間の抵抗もデジタル的に制御された相補抵抗 R_{WA} として発生されます。 R_{WA} でも最大絶対抵抗誤差は 8% です。 R_{WA} は最大抵抗値から開始して、ラッチにロードされるデータが大きくなると減少します。この動作の一般式は次のようになります。

AD5123:

$$D_{3I(6)} = \frac{128-6}{128} \times D_{34} + D_7 \quad 0x00 \sim 0x7F \quad (3)$$

AD5143:

$$D_{3I(6)} = \frac{256-6}{256} \times D_{34} + D_7 \quad 0x00 \sim 0xFF \quad (4)$$

ここで、

D は、 $7/8$ ビット RDAC レジスタにロードされるバイナリ・コード・データの 10 進数表示。

R_{AB} はピン間抵抗。

R_W はワイパー抵抗。

デバイスがリニア・ゲイン設定モードに設定されると、ピン W とピン A の間の抵抗は、対応する RDAC レジスタにロードされたコードに比例します。この動作の一般式は次のようになります。

AD5123:

$$D_{3I(6)} = \frac{6}{128} \times D_{34} + D_7 \quad 0x00 \sim 0x7F \quad (5)$$

AD5143:

$$D_{3I(6)} = \frac{6}{256} \times D_{34} + D_7 \quad 0x00 \sim 0xFF \quad (6)$$

ここで、

D は、 $7/8$ ビット RDAC レジスタにロードされるバイナリ・コード・データの 10 進数表示。

R_{AB} はピン間抵抗。

R_W はワイパー抵抗。

ボトムスケール状態またはトップスケール状態では、有限な合計ワイパー抵抗が 40 Ω になります。デバイスが動作している設定値に無関係に、ピン A とピン B 間、ピン W とピン A 間、ピン W とピン B 間の電流を ±6 mA の最大連続電流に、または表 5 に規定するパルス電流に、制限するように注意してください。そうしないと、内部スイッチ・コンタクトの性能低下または破壊が生ずる恐れがあります。

ポテンショメータ分圧器のプログラミング

電圧出力動作

デジタル・ポテンショメータは、A—B 間の入力電圧に比例した分圧電圧を W—B 間および W—A 間に容易に発生することができます(図 38 参照)。

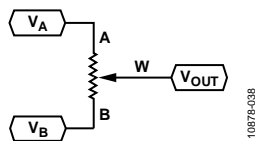


図 38.ポテンショメータ・モード構成

ピン A を 5 V へ、ピン B をグラウンドへ、それぞれ接続すると、ワイパー W とピン B の間に 0 V~5 V の範囲の出力電圧が得られます。ピン A とピン B に与えられる有効な入力電圧に対する出力電圧 V_W (グラウンド基準)を求める一般式は次のようになります。

$$H_1(\theta) = \frac{D_4(\theta)}{D_{34}} \times H_3 + \frac{D_{31}(\theta)}{D_{34}} \times H_4 \quad (7)$$

ここで、

$R_{WB}(D)$ は式 1 と式 2 から求めることができます。

$R_{AW}(D)$ は式 3 と式 4 から求めることができます。

分圧器モードでのデジタル・ポテンショメータの動作は、温度に対して正確な動作になります。可変抵抗器モードと異なり、出力電圧は絶対値ではなく内部抵抗 R_{AW} と R_{WB} の比に依存します。したがって、温度ドリフトは 5 ppm/°C に減少します。

ピン電圧の動作範囲

AD5123/AD5143 は、内蔵保護 ESD ダイオードを使ってデザインされています。これらのダイオードも、ピン動作電圧の範囲を決定しています。A、B、W の各ピンで正信号が V_{DD} を超えると、順方向にバイアスされたダイオードによりクランプされます。 V_A 、 V_W 、 V_B の間には極性の制約はありませんが、これらの電圧は V_{DD} を上回ることはできません。

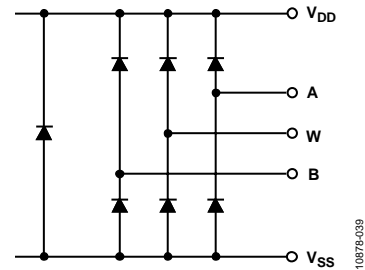


図 39. V_{DD} と V_{SS} により設定される最大ピン電圧

パワーアップ・シーケンス

ピン A、ピン B、ピン W での電圧コンプライアンスを制限するダイオードが内蔵されているため(図 39)、ピン A、ピン B、ピン W に電圧を加える前に先に V_{DD} を加えることが重要です。そうしないと、ダイオードが順方向バイアスされて、意図せずに V_{DD} に電源が接続されてしまいます。最適なパワーアップ・シーケンスは、 V_{SS} 、 V_{DD} 、デジタル入力、 V_A 、 V_B 、 V_W の順序です。電源投入シーケンス V_A 、 V_B 、 V_W 、デジタル入力の順は、 V_{SS} と V_{DD} 投入後であれば、重要ではありません。パワーアップ・シーケンスと電源のランプ・レートに無関係に、 V_{DD} が投入されると、パワーオン・プリセットが起動し、EEPROM に格納された値が RDAC レジスタへ転送されます。

レイアウトと電源のバイパス

小型で最短の線によるレイアウト・デザインは重要です。入力までの線は、最小の導体長で可能な限り真っ直ぐにします。グラウンド・パスの抵抗とインダクタンスは小さくする必要があります。高品質のコンデンサを使って電源をバイパスすることも重要です。ESR の小さい 1 μF~10 μF のタンタル・コンデンサまたは電解コンデンサも電源に接続して、過渡電圧を抑え、かつ低周波リップルを除去する必要があります。図 40 に、AD5123/AD5143 に対する基本的な電源バイパス構成を示します。

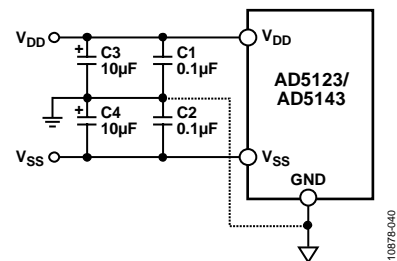


図 40.電源のバイパス

外形寸法

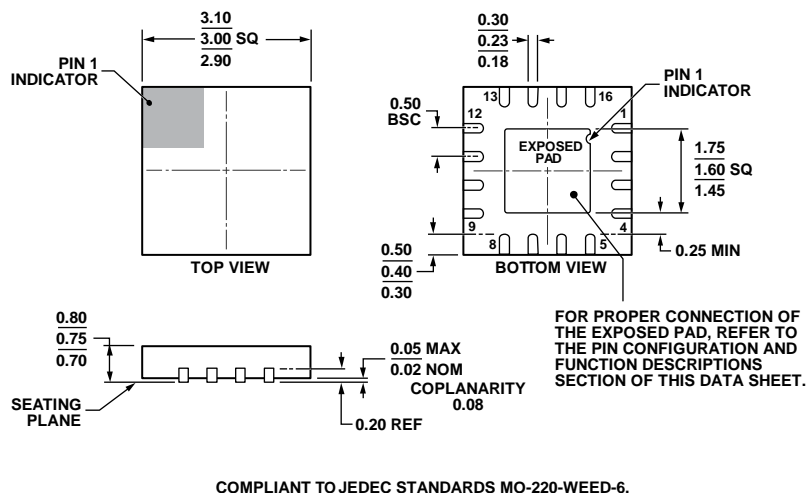


図 41.16 ピン・リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP_WQ]
3 mm x 3 mm ボディ、極薄クワッド
(CP-16-22)
寸法: mm

オーダー・ガイド

Model ^{1,2}	R _{AB} (kΩ)	Resolution	Interface	Temperature Range	Package Description	Package Option	Branding
AD5123BCPZ10-RL7	10	128	I ² C	-40°C to +125°C	16-Lead LFCSP_WQ	CP-16-22	DGZ
AD5123BCPZ100-RL7	100	128	I ² C	-40°C to +125°C	16-Lead LFCSP_WQ	CP-16-22	DH0
AD5143BCPZ10-RL7	10	256	I ² C	-40°C to +125°C	16-Lead LFCSP_WQ	CP-16-22	DH1
AD5143BCPZ100-RL7	100	256	I ² C	-40°C to +125°C	16-Lead LFCSP_WQ	CP-16-22	DH2
EVAL-AD5143DBZ					Evaluation Board		

¹ Z = RoHS 準拠製品。

² 評価用ボードは 10 kΩ R_{AB} の抵抗オプションで出荷されますが、ボードは使用可能な全抵抗値オプションと互換性があります。

I²C は、Philips Semiconductors 社(現在の NXP Semiconductors 社)が制定した通信プロトコルです。